卒 業 論 文



2025年4月13日

柳凜神吉陽介西田汐里猪上竣河野朱慧

神戸大学 理学部 物理学科 粒子物理学研究室

概要

本研究は KEK 筑波キャンパス PF-AR(Photon Factory-Advanced Ring for Pulse X-ray) に設置されている KEK 測定器開発テストビームライン の電子ビーム性能を調べることを目的とした。ビーム形状の位置依存性 を測定することにより、ビームラインの最適化に寄与することを目指し た。ビーム性能調査のために測定器開発を行い、測定器の検出器効率を 測定した後、ビーム形状測定実験を実施した。また、同じ検出器で遮蔽 体を置き、電磁シャワーの形状測定も行った。その結果を基に、得られ たデータの解析および考察を行った。

目 次

第1章	序論	1
第2章 2.1 2.2	KEK 測定器開発テストビームライン KEK PF-AR テストビームラインのビーム生成・輸送方法	3 3 4
第3章	電子位置検出器	8
3.1	検出器のコンセプトと設計...................	8
3.2	MPPCとNIM-EASIROC	10
	3.2.1 MPPC	10
	3.2.2 NIM-EASIROC	12
	3.2.3 ADC 光電子変換	13
3.3	測定時のセットアップ	16
第4章	検出器の性能評価・較正	19
4.1	ファイバーの性能評価	19
	4.1.1 平均光電子数による評価	19
	4.1.2 クラスタリングによる評価	22
4.2	検出効率による性能評価・較正	25
	4.2.1 検出効率測定実験の Setup と読み出し系	25
	4.2.2 検出効率の定義と原理	26
	4.2.3 シミュレーションの用意	26
	4.2.4 検出効率導出にあたって考慮しなければならない現象	27
	4.2.5 検出効率実験の結果と検出効率の導出	28
第5章	ビーム形状測定実験の解析と結果	31
5.1	実験のセットアップ	31
5.2	シミュレーションとの比較................	32
	5.2.1 SAD を用いたシミュレーションの用意	33

第7章	結論	50
6.4	結果	46
6.3	解析方法	45
6.2	実験のセットアップ	44
6.1	電磁シャワー生成の原理	43
第6章	電磁シャワー形状測定実験	43
5.3	測定データとシミュレーション結果の一致度と問題点	42
	5.2.4 広がりの比較	39
	5.2.3 焦点位置の比較	37
	5.2.2 ビーム形状の比較	33

第1章 序論

本研究では、高エネルギー加速器研究機構(KEK)筑波キャンパス PF-AR(Photon Factory-Advanced Ring for Pulse X-ray)に設置されている KEK 測定器開発テストビームラインにおけるビーム形状を測定し、シミュ レーション結果と比較する。これにより、シミュレーションの精度向上 やビームラインの改善に向けた指針を得ることを目的とする。

ビームラインにおける四重極磁石は、ビームの収束や発散を調整する ために用いられている。磁石に流す電流値によって発生する磁場の強さ が変化し、それに伴いビームの収束度合いが変化する(詳しくは第2章2.2 節)。現在、測定器開発テストビームラインでは四重極磁石を通してより 多くの電子を輸送することを重視して、シミュレーションに基づいた最 適な電流値を算出し、その値を既定値としてビームの調整が行われてい る。しかし、下流でのビームの広がり、ビーム輸送シミュレーションプ ログラムによる結果が実際のビームとずれていることなど、依然として いくつかの課題が残されている。

本研究では、シンチレーションファイバーを用いてビーム形状を二次 元で読み取ることが可能な検出器を作成し、これを用いて四重極磁石に 流す電流の大きさを変化させた際のビーム形状を測定した。測定データ から得られたビームの広がりと、最適な電流値の算出のために用いられ たシミュレーションから得たビームの広がりとを複数の観点から比較し、 上記のずれの原因を探った。また、自作の検出器を用いて鉛ブロックに よる電磁シャワーの測定も行った。

今回は KEK が実施している「加速器科学インターンシップ」を利用し て測定器開発テストビームラインでの実験を行った。そのために 2024年 11月 22日から 11月 30日まで KEK に滞在した。11月 22日から 11月 24 日に装置の準備や予備実験等を行い、11月 25日から 11月 27日に検出器 の較正に必要な測定 (詳しくは第4章 4.2節)、11月 28日から 11月 29日 に電子ビームの形状測定と電磁シャワー測定を実施した。また、実験は東 京大学素粒子物理国際研究センター (ICEPP) と同じエリアで同時に行っ た。検出器の較正のための測定時には ICEPP の検出器をビーム上流に設置し、本研究のための装置はその下流に設置した。ビーム形状測定および電磁シャワー測定時は本研究の検出器をビーム上流に設置した。

本論文では、まず第2章において測定器開発テストビームラインについて紹介し、第3章で作成した検出器やその他用いた実験装置について述べる。第4章で検出器の検出効率を求め、その結果を踏まえて第5章にて測定したビーム形状とシミュレーションとの比較結果を示す。さらに、第6章で電磁シャワーに関する解析結果を述べる。

第2章 KEK測定器開発テスト ビームライン

2.1 KEK PF-AR

KEK とは高エネルギー加速器研究機構の略称である。高エネルギー加 速器は、電子や陽子などの粒子を光速の近くまで加速させ、衝突により 高いエネルギー状態を作り出す装置である。本メンバーは、卒業研究と して、その KEK つくばキャンパス内にある PF-AR (Photon Factory -Advanced Ring for Pulse X-Ray、図 2.1)の測定器開発テストビームライ ンで実験を行った。



図 2.1: KEK つくばキャンパスの航空写真(2023 年)[1]。赤線で囲われ た部分が今回実験を行った PF-AR である。

PF-AR は大強度パルス放射光を供給する円型光源加速器である(円周 377 m)。加速された電子は蓄積リングを周回する。電子が磁場によって 進行方向を曲げられる際に生成される放射光を取り出す。この放射光の 特徴の一つは「シングルパンチ」という点である。「パンチ」とは群れ・集 合を意味する。一般的には、複数の電子の群れ(マルチパンチ)が加速器 内のリングを周回している状態で運転され、放射光が連続的に到達する ように見える。一方、PF-AR のようにシングルパンチの場合では、ある1 点で光を見ると、電子の群れが一周する間に一回だけ光るため、非常に短 い時間スケールで起こる現象の一瞬一瞬を観察することができる。また、 1 発で物質の構造を捉える光には十分な強度が必要であるため、放射光は 大電流である。PF-AR は 50-60 mA で 1.3 μs 間隔の大強度パルス放射光 源として利用されている。非常に明るい写真を撮れることは、約1 MHz で繰り返すストロボカメラで写真を撮ることに例えられる。今回私たち は、その PF-AR 内の電子ビームを利用した「測定器開発テストビームラ イン」にて実験を行った。

2.2 テストビームラインのビーム生成・輸送方法

図2.2はテストビームの構造図である。図2.3のように、PF-AR 内のリ ングにワイヤーターゲット(直径0.1 mmの carbon nanotubeの撚糸と厚 さ 40 µmのグラフェンシートを材質として使用)を挿入する。PF-AR 内 の 6.5 GeV の電子とワイヤー内の原子との間の電磁相互作用の制動放射 によってガンマ線を生成する。ガンマ線を銅製コンバータ(図 2.4)に入 射させ、電子陽電子対を生成する。その電子をQマグネット(Quadrupole magnet:四重極磁石)で収束させ、Bマグネット(Bending magnet:偏 向用双極電磁石)で特定の運動量のみ取り出し、再びQマグネットで収 束させ、ビームステージにビームを輸送する(図 2.5)。テストビームラ インでは 0.5 GeV 程度から 5.0 GeV までの電子ビームを利用できる。

QマグネットにはQFとQDの二種類がある。F、Dは図 2.6 に表記したx方向に対してFocus、Defocusの略である。例えば、QFの場合は図のようにN極とS極を配置する。磁場は緑色の矢印の方向に発生し、電子は白色の矢印の方向に力を受ける。よって、電子ビームはx方向に収束すると同時に、y方向には拡散する。逆にQDマグネットでは、ビームはx方向では拡散し、y方向には収束する。Qマグネットの電流値を変化させることで磁場の大きさを変化させ、ビームの収束を調整する。PF-AR



図 2.2: テストビームラインを上から眺めた図とビームステージの写真 [2]



概略図 [2]

図 2.4: コンバータの概略図 [2]

のリング側にQFが1個、QDが2個、ビームステージ側にQFが2個、 QD が 2 個、計 7 個の Q マグネットが設置されている。

Bマグネットでは、まずコイルに電流を流し、図2.7のようにコイルの両 端にN極とS極を発生させる。すると、白色の矢印方向に磁場が生じる。 黄色の矢印のように紙面奥から手前にやって来た電子は水色の矢印の方 向にローレンツ力を受け、円軌道を描く。その円軌道の半径はr = p/qB (r:半径、p:電子の運動量、q:電子の電荷量、B:磁束密度)で表され、 電子の運動量と磁場の大きさに依存する。よって、磁場の大きさ、つま りコイルに流す電流値を調整することで特定の運動量の電子のみを取り 出すことができる。



図 2.5: ビームステージの写真。右の黄色の長方形がビームシャッターであり、ビームの使用に合わせてシャッターを開閉する。左の4つのオレンジの円筒で囲われたものはQマグネットであり、右の2つがQF、左の2つがQDである。また、フェンスの向こう側が本実験の検出器を置くスペースである。



図 2.6: Qマグネットの写真。QFの場合、N 極と S 極を上記のように配置する。磁場は緑色の矢印の方向に発生し、電子は白色の矢印の方向に 力を受ける [3]。



図 2.7: Bマグネットの写真。橙色の円がBマグネット。白色の矢印は磁場の方向、黄色は電子ビームの進行方向、水色はローレンツ力の方向を表している [3]。

第3章 電子位置検出器

この章では、本実験で用いた、電子の通過位置を測るための検出器に ついて述べる。本実験の目的は、電子ビームの広がりを2次元で観察す ることである。そのために、シンチレーティングファイバーを直交させ て並べ、電子の通過により発生した光を MPPC(3.2.1 章で説明)で読み 出す検出器を製作した。読み出しには NIM-EASIROC モジュール(3.2.2 章で説明)を使用した。

3.1 検出器のコンセプトと設計

測定対象の電子ビームの広がりは数 cm を想定している。そのため、数 cm の範囲を数 mm の分解能で、縦横二方向について測定できるような検 出器を設計した。信号の読み出しに用いた NIM-EASIROC モジュールに は 32 チャンネルを読み出せる ASIC が 2 つ搭載されていた。そのため、 縦横方向にそれぞれ 32 チャンネルとした。ビーム検出のために、直径 0.7 mm(発光する有効部分の直径 0.658 mm)のプラスチックシンチレー ションファイバー (SCSF-78M 改良 11)を使用した。このファイバーは2 層に接着されていたため、図 3.1 のように 6 本を 1 セットとして用いた。 これにより、およそ 2.1 mm の検出単位幅を確保しつつ、32 チャンネル で 2.1 mm × 32 ~ 7 cm という十分な測定範囲を得ることができた。ま た、エネルギー損失の小さいプラスチックシンチレータを用いることで、 ビームに与える影響を小さくした。

そのプラスチックシンチレーションファイバーからの光を検出するために MPPC を用いた。6本のファイバーを束ねたものからの光を1個の MPPC が検出できるように、ファイバーの端が MPPC に向くように設置する。これを1つのチャンネルとして扱った。図3.2 はこのチャンネルを縦横に並べた図になっている。これにより直交したファイバーが重なった部分が、電子の通過位置を検知する検出領域となる。測定時は、光ったチャンネルの組み合わせから、電子の当たった位置を特定した。



図 3.1:1つのチャンネルの構造とサイズ



図 3.2: 検出器の有効面とファイバーの構造とサイズ

MPPCからのからの信号を得るために、MPPCの付いた基板を製作し、 信号はツイストケーブル経由で電気信号として取得した。このケーブル は後述する NIM-EASIROC に接続し、NIM-EASIROC が MPPC からの 信号をデジタル化した。

検出器全体は、プラスチックカバーや暗幕で遮光した。完成した検出 器を図 3.3 に示す。



図 3.3: ファイバー検出器

3.2 MPPCとNIM-EASIROC

本節では、検出器の構成と測定に重要となる MPPC、NIM-EASIROC 及び ADC 光電子変換について述べる。

3.2.1 MPPC

MPPC(Multi-Pixel Photon Counter)は、浜松ホトニクスが製造する SiPMの商品名であり、受光面に入射した光量をパルス状の電気信号に変 換する装置である。

受光面には多数の Avalanche Photo Diode(APD) が図 3.4 の通りピクセ ル状に備え付けられている。ダイオードに逆電圧をかけた時、半導体内 に大きな電場が生じることで半導体内で電子雪崩が起き、信号を増幅さ せる。入射する光子数が APD の数より十分小さい時には、微細な 1 つの APD に対して 1 つの光子のみが入射すると考えられる。APD に光が入 射すると一定の飽和信号を出すように、ガイガーモードでの増幅が起こ るような高い電圧を印加する。すると MPPC の出力信号は飽和信号単位 で離散化され、何個の APD で光電子が発生したのかが分かる。



図 3.4: 受光面 [4]

半導体内部では、光によって生成されたキャリアだけではなく、熱的 に発生したキャリアによっても電流が発生する。これを暗電流(ダーク カレント)と言い、ノイズの主要因である。



図 3.5: MPPC 基板

本実験の検出器で使用した MPPC の性能は以下の通りとなる。

- 受光面: 3.0 mm×3.0 mm
- MPPC 型番: S13360-3075PE
- ピクセル数:1600
- 検出効率 (PDE):約 50%
- ガイガーモードを生じる降伏電圧:53±5 V

各方向それぞれのチャンネルの総数が 32 であるため、MPPC の総数も 32 個となる。図 3.5 は MPPC を 32 個貼り付けた基板である。

各チャンネルに相当するシンチレーションファイバーと MPPCは、ファ イバー断面と MPPC の受光面が対面するように設置した。基板と同じ大 きさのゴム版に基板に張り付けた MPPC と同じ位置に穴をあけ、ファイ バーと基板を固定した。これにより、シンチレーションファイバーで生 じた光を MPPC で検出し、後述する NIM-EASIROC で ADC 値として読 み出せるようにした。

3.2.2 NIM-EASIROC

NIM-EASIROC(Extended Analogue Silicon pm Integrated Read Out Chip) は、64 個の MPPC に同時にバイアス電圧をかけて駆動し、信号を 読み出すことが出来るモジュールである (図 3.6)。



図 3.6: NIM-EASIROC 本体

計測時には、MPPC に高電圧を掛けた状態で入力するトリガー信号の タイミングを調整し、図 3.7 のようにピークの高さを保持(ピークホール ド)させる。その電圧、つまり波のピーク時の波高を ADC(Analog Digital Converter)でデジタル情報(ADC 値)に変換し、その情報を TCP/IP 通 信によりネットワーク経由でコンピュータで読み出すことができる。ま た、NIM-EASIROC は各 MPPC にバイアス電圧を供給することができ、 またバイアス電圧を調整する機能を持つ。



図 3.7: ピークホールドの様子(上図) (縦軸:電圧 横軸:時間)

3.2.3 ADC 光電子変換

MPPC からの信号を NIM-EASIROC で読み出すと、図 3.8 のように離 散化されている。この図は MPPC に LED 光を当て、LED が光るタイミ ングで信号を読み出したときの結果である。



図 3.8: MPPC に LED を当てた時の ADC 値分布

離散化された信号の各ピークが光電子数に対応している。これをもと に各ピークの ADC 値と光電子数の関係を調べると、図 3.9 のようになる。 MPPC が出す信号は APD の飽和信号単位であるから、各ピーク間は一定となり、ADC 値と光電子数の関係は1次関数で表せることが、この結果からわかる。各 ch についてこの関係を求め、実験結果の ADC 値を光電子数に変換する。



図 3.9: ADC 値光電子数変換の導出。左は 16ch の ADC 値分布の各ピー クをガウスフィットしたグラフ。右はピークの ADC 値と光電子数のグラ フ。この関係を用いて MPPC から得た ADC 値を光電子数に変換できる。

ただし、多数の MPPC から入力があり、NIM-EASIROC が大きい信号 を出さなければならない状況では、MPPC に加わるバイアス電圧が下が ることがわかった。一例として、18ch の ADC 値分布を X 方向の ADC 値 合計ごとに分類したものを図 3.10 に示す。X 方向 32ch の ADC 値合計が 1 つの EASIROC chip が出した信号の合計になるが、それが大きくなる ほど信号の分布が下がっていることが分かる。



図 3.10: MPPC 15ch の ADC 値分布の ADC 値合計に対する依存性。X 方向 32ch の EASIROC chip からの ADC 値合計が 29000-30000(左上)、 34000-35000(右上)、39000-40000(左下)、44000-45000(右下)の場合につい て、X 方向の 15ch の ADC 値分布を示す。

位置スキャンとプロファイル測定では3つ以上の MPPC から信号が来 る事象が少なかったため、この特性は問題にならない。しかし、電磁シャ ワー測定の場合は検出器に当たる粒子数が多くなるため、このことを考 慮する必要があった。そのため、電磁シャワー測定のデータのみ解析時 にデータの補正を行った。

補正は、0 光電子数の信号の位置 (ペデスタル) が ADC 値合計の1次関 数で表せると考えて行った。具体的には、各 ADC 値合計についてペデス タルの位置を調べ、ADC 値合計が 27000 の時のペデスタルに合うように



図 3.11: ADC 値合計とペデスタルの位置

した。ピーク間の間隔は変化していないと考えて補正した。補正結果が 図 3.12 である。補正を行うことで信号が離散化され、補正がうまく行っ たことがわかる。これにより、検出器に多数の粒子が入った場合も光電 子数を正確に評価できるようになった。

3.3 測定時のセットアップ

上記のファイバー検出器を用いて、2024年11月22日から11月29日 まで測定器開発テストビームラインで測定を実施した。ビームタイムの 制限の関係で、東京大学素粒子物理国際研究センター (ICEPP) と同時に 測定を行った。そのため、ビーム上流、もしくは下流に東京大学の装置 (パラサイト実験検出器)が存在した。

測定時のセットアップの一例を図 3.13 に示す。



図 3.13: 本実験全体のセットアップ図

マグネット前のT0シンチ、マグネット後のT4シンチ、検出器直前の トリガーシンチ2、検出器後のトリガーシンチ1を組み合せてトリガー 論理を構成した。シンチレータはいずれもプラスチックシンチレータで ある。T0シンチは、ビームシャッターが開き、ビームがステージに来た ということを確認するために用いた。T4シンチはマグネットを通過した ビームを選別するために用いた。トリガーシンチ1、2は1 cm 角のプラス チックシンチレータで、ビーム軸を基準として同じ位置に配置した。2つ のトリガーシンチの同時検出により、荷電粒子がビーム軸に垂直な平面 の1 cm 角の範囲を通過したことを示すトリガー信号を生成する。また、 図 3.13 では、東京大学の検出器がビーム上流にある場合を示す。 検出器の読み出し回路を図 3.14 に示す。この回路のコインシデンスモ ジュール (図中の"Coinc") により、トリガー条件をスイッチで切り替え られるようにした。コインシデンスの出力に適切な delay をかけて NIM-EASIROC のトリガーに入力した。コインシデンス出力に delay をかけた ものをコインシデンスの veto に入力することで、NIM-EASIROC がデー タを読み出している間に次のトリガーが入ることを避けた。また、クロッ ク信号を veto に入れてマスター信号として用い、読み出し機器の動作を コントロールした。クロック信号が動いていない場合に常に veto が on に なるようにすることで、クロックの開始により測定を開始できるように した。



図 3.14: 検出器からの読み出し回路

第4章 検出器の性能評価・較正

この章の最終目標は、電子位置検出器の効率測定である。それに向け て、まずファイバーの性能評価を、平均光電子数・ファイバーのクラス タリングに着目して行った。その後、検出効率を決定した。

4.1 ファイバーの性能評価

4.1.1 平均光電子数による評価

ある ch に電子ビームが当たったとき、その ch が発した光がもととな り、各光検出器にどれだけの光電子が生成されたかを調べた。まず、トリ ガーシンチ 1、トリガーシンチ 2 のコインシデンスでトリガーをかけたと きに、ビームが当たる 1 cm 角の範囲(これを以下「ビーム面」と呼ぶ)に 含まれる X 軸のあるチャンネルについて見る場合について説明する。図 4.1 のように、ビーム面に含まれている Y 軸の 3 つの ch いずれかが光っ たとき、その X 軸の ch がいくつ光電子を出したかを調べる。

そうして得られた X 軸の1つの ch の光電子数の分布(図 4.2)の0 光電子のイベント数と、ランダムトリガーで取得したノイズランの分布(図 4.3)の0 光電子のイベント数の値を合わせて規格化し、図 4.2 から図 4.3 を引く。そうして得られた分布が図 4.4 である。

ここで、図 4.4 の分布をポアソン分布とみなし、図 4.4 の mean をポア ソン分布の μ とする。この μ を該当 ch の平均光電子数とする。Y 軸につ いてもこの作業を同様に行うことで、全 ch の平均光電子数を求めること ができる。図 4.5 の青線が各 ch の平均光電子数である。

図 4.4 を見ると、信号に対して光電子数のピークが見え、閾値を設定 することにより、電子を通過した事象を選別できると考える。今回は、 $\mu - 1.5\sqrt{\mu}$ を各 ch の閾値とする。ただし、 $\mu - 1.5\sqrt{\mu} < 3.5$ となる場合に は、閾値を 3.5 として下限を設ける。図 4.5 の赤線が各 ch の閾値である。 以降の解析ではこの閾値を用いる。



図 4.1: 検出器の一部分に電子ビームが当たったときの概略図。青色の正 方形はビーム面 (1cm 角)、黄色の長方形はビーム面に含まれている Y 軸 の 3 つの ch、赤色の長方形は今注目している X 軸の ch を表している。



図 4.3: ノイズランをしたときの 3ch の光電子数の分布



図 4.4: 図 4.2 と図 4.3 の 0 光電子のイベント数を合わせて、図 4.2 から図 4.3 を引いたときの、3ch の光電子数の分布。赤線はこの ch の閾値である。



図 4.5: 青線が各 ch の平均光電子数、赤線が各 ch の閾値。右図が X 軸、 左図が Y 軸に関する分布。

4.1.2 クラスタリングによる評価

検出器の構造上、電子ビームが異なるチャンネルの中間を通過すると、 連続して異なるチャンネルが同時に光る可能性がある。また,前方に他 の実験の検出器などの物質があり,その物質量が放射長の程度以上であ れば,電子は多くの場合制動輻射を起こす。さらに放射された光子が対 生成を起こすと,複数の電子・陽電子がビーム軸から小角度に放射され, やはり複数のチャンネルが光る可能性がある。ファイバー検出器の前方 にパラサイト実験検出器が設置されていた場合とされていない場合を比 較した際、連続して光ったファイバーの割合がどれほど増減するのかを 調べるためにクラスタリングを行った。

先に求めた閾値以上の光量が MPPC に伝わったチャンネルに「1」、伝 わっていないチャンネルに「0」と判定結果を割り当てる。「1」がどれほ ど連続しているのか、つまり1クラスターに含まれるファイバーのチャ ンネル数を求め、その規格化された分布を見る。



図 4.6: クラスター内のチャンネル数の分布を規格化したもの。青線がパ ラサイト実験検出器が前方に無い場合におけるクラスター数の分布、赤 線がパラサイト実験検出器が前方にある場合におけるクラスター数の分 布を示す

図4.6から、3チャンネル以上連続して光るクラスター数は1チャンネ ル・2チャンネル連続して光るクラスター数と比較して無視できる大きさ である。パラサイト実験検出器が前方に無い場合と比較して、パラサイ ト実験検出器が前方にある場合における2チャンネル連続して光るクラ スター数は、X軸・Y軸共に増加している。これは、制動放射によって生 じた電子・陽電子がチャンネル間に入射したからであると考えられる。

次に、X軸・Y軸の各チャンネルの位置で1チャンネルのみ光ったクラ スター数の位置分布を見る。パラサイト実験検出器が前方に設置されて いない場合、ファイバー検出器の有効面の中心にトリガーシンチレータ をかけた測定データを調べると図 4.7 の通りとなる。



図 4.7: クラスターの位置分布をチャンネル数で表したもの。トリガーが かかっている範囲を横軸に赤文字で記載。

トリガーシンチレータを通過した電子ビームが信号を残していること が、トリガーした位置に相当するチャンネルでのクラスター数の増加と して確認することができる。また、トリガーの外側ではクラスターがほ ぼ見られないことも確認できる。

パラサイト実験検出器による制動放射の影響を調べるため、パラサイト実験検出器が前方に設置されている場合、ファイバー検出器の有効面の中心にトリガーシンチレータをかけた測定データを図4.7に追加して比較する。なお、分布は両者ともに正規化されている。



図 4.8: クラスターの位置分布をチャンネル数で表したもの。青線がパラ サイト実験検出器が全面に無い場合におけるクラスター数が1つの分布、 赤線がパラサイト実験検出器が全面にある場合におけるクラスター数が 1つの分布を示す

図4.8におけるトリガー外側の赤線に注目すると、制動放射の影響によ るビーム中心からの広がりが確認できる。

以上のような影響は見られるが、トリガーを通過した電子ビームの中 心位置の確認は可能である。

4.2 検出効率による性能評価・較正

検出効率を求めることで、本章の目的である検出器の性能評価・較正 を行う。検出効率により検出器を補正することで、ビーム形状測定実験 や電磁シャワー形状測定実験の解析に活用することができる。

4.2.1 検出効率測定実験の Setup と読み出し系

まず、検出効率を導出するために行った実験の Setup と読み出し方法 について説明する。検出効率測定実験のセットアップを図 4.9 に示す。



図 4.9: 検出効率測定実験のセットアップ

図4.9に示してあるトリガーシンチ1,2は1 cm 角であり、ビームを1 cm 角に絞るために4つのシンチレータのコインシデンスでトリガーを出し ている。検出器の位置を1 cm 間隔で上下左右に動かし、1 cm 角に絞った ビームを検出面のすべての場所に当てた。また、Q マグネットの電流値 は規定値、ビームのエネルギーは 3.0 GeV に設定した。

4.2.2 検出効率の定義と原理

検出効率を求めるにあたり、ファイバーの束と MPPC の1 セットを1 つのチャンネルとして、チャンネルごとの検出効率を求める。本来、検 出効率はそのチャンネルに粒子が通過したことをトリガーなどで保証で きれば、実際のチャンネルの感度を絶対値として求めることができる値 である。しかし、以下で論じる通り、1 cm 角のトリガーシンチに対して ファイバーがどこに位置しているかの影響を非常に大きく受けているこ とから、絶対値として求めることが困難である。したがって、本実験では 検出効率実験のシミュレーションを用意し、実験と比較することで、検出 効率を相対値として求めた。検出効率の導出に用いた式を式 4.1 に示す。

4.2.3 シミュレーションの用意

相対検出効率を求めるために geant4 を用いた検出効率測定実験のシミュ レーションを用意した [5]。シミュレーションでは実験と同様の位置関係 にトリガーシンチと検出器を設置し、チャンネルの形状も模倣した(図 4.10)。また、初期粒子は図 4.9 の T4 シンチ(2.5cm×5.0cm)から打ち 出し、ビームが検出面で縦 12.6 mm,横 12.6 mm の広がりになるように設 定した。シミュレーションの配置図を図 4.11 に示す。



図 4.10: シミュレーションで再現したチャンネルの形状 [5]



図 4.11: シミュレーション配置図 [5]

4.2.4 検出効率導出にあたって考慮しなければならない現象

検出効率を求める前に考慮しなければならない現象がある。隣り合っ たファイバー間を電子が通過した際に複数のファイバーが光る現象があ るが、この問題は4.1のクラスタリングを用いることで解決できた。し かし、図4.12のように四角で囲った範囲の対角線上の頂点を電子が同時 に通過した際、矢印の位置にも電子が来たように見える問題がある。こ の事象を排除するためには見たいチャンネルでない方向のチャンネルに ついて、1チャンネルのみを要求する必要があった。取得イベント数は 減少してしまうが、この方法でデータを解析した。また、実験データと シミュレーションデータには閾値を設定する必要がある。実験データの 閾値は4.1で説明した平均光電子数をもとにチャンネルごとに決定した。



図 4.12: 排除すべき事象

これに対してシミュレーションデータの閾値はファイバー内でのエネル ギー損失に課した。図 4.13 は 1 チャンネルのみを見たときのエネルギー 損失分布である。これを見ると、山が二つできており、エネルギー損失 が小さい山は一つのファイバーしか通過しなかった場合であると考えら れる。よって、実験データの閾値がファイバーのシンチレータ部分をほ ぼ 2 本分通過しているものを選別していると仮定すると、エネルギー損 失の閾値は 0.15 MeV が適切であるとわかる。



図 4.13: 1 チャンネルにおけるエネルギー損失の分布

4.2.5 検出効率実験の結果と検出効率の導出

まず、検出効率実験によるチャンネルごとの取得イベント数分布を示 す (図 4.14)。



図 4.14: 検出効率実験のチャンネルごとの取得イベント数分布(実験値)

次に、図 4.15 に示すように、チャンネルごとの取得イベント数をトリ ガーによる取得イベント数で割ったもの (式 4.1 の分母と分子)を、実験 とシミュレーションで比較する。



図 4.15: チャンネルごとのシミュレーションと検出効率測定実験の比較 (赤線がシミュレーション、青線が実験値)

対象範囲 1cm の実験結果とシミュレーションの結果が、少なくともト リガーシンチレータの中央付近では類似しており、比較することができ るとひとまず仮定する。これをもとに式 4.1 からチャンネルごとの検出 効率を求めると 図 4.16 のようになる。ここで、図 4.16 を見ると一定間 隔で凸凹が生じていることが分かる。これは、トリガーシンチに対して ファイバーが位置する場所の影響を大きく受けていることを示している。 図 4.15 をもう一度見ると、トリガーシンチレータの端面付近ではシミュ レーションがデータの効率の振る舞いを再現しておらず、それが原因だ と考えられる。



図 4.16: チャンネルごとの相対検出効率: 点線はトリガーシンチの端

以上で検出効率を求めることができたが、1cm ずつ検出器を動かすの ではなく、0.5 cm ずつ動かすことで、どの検出器チャンネルに対してもト リガーシンチレータの中央付近で効率を測定でき、トリガーシンチレー タの位置関係による影響を受けることがなかったのではないかと推測さ れる。

以上で求めた各チャンネルのシミュレーションとの相対検出効率を5 章で導出された実験結果に適用し、チャンネルごとの性能差を考慮した ビーム形状を導くことに活用した。

第5章 ビーム形状測定実験の解 析と結果

この章では、第3章で製作した検出器を用いて測定したテストビームラ インのビーム形状について示す。特に、QSD、QSFの電流値とビーム形 状の関係について述べる。また、得られたビーム形状をシミュレーショ ン結果と比較する。

5.1 実験のセットアップ

ビーム形状測定のための実験セットアップを図 5.1 に示す。



図 5.1: ビーム形状測定実験のセットアップ

ビームがステージまで到達していることを保証するため、T0 シンチレー タのみをトリガーとして使用した。また、ビームの焦点を求めるために 検出器の設置場所として *z* = 745 mm、*z* = 1187 mm の 2 点を設け、それ ぞれについて測定を行った。z = 0 mm の点は T4 シンチレータの位置と している。以下、z = 745 mm の位置を上流、z = 1187 mm の位置を下流 と呼ぶ。Q マグネットの電流値については QRF と QRD では既定値から 変更せず、QSF と QSD のみを変化させた。各ビームエネルギーにおける 電磁石の規定の電流値を以下の表 5.1 に示す。また、QSF、QSD における 変化の割合と電流値について表 5.2、表 5.3 に示す。ただし、QSF、QSD の最大定格電流は28Aである。

$p \; [\text{GeV/c}]$	BEND [A]	QRF[A]	QRD [A]	QSF[A]	QSD [A]
0.5	15.61	8.0	3.4	3.9	4.2
1.0	32.93	15.9	6.7	7.8	8.4
2.0	66.50	31.7	13.3	15.7	16.7
3.0	100.23	47.5	20	23.5	25
4.0	133.89	50	26	28	28
5.0	168.08	50	28	28	28

表 5.1: 各ビームエネルギーにおける電流値

change ratio [%]	QSF[A]
15	27.025
10	24.675
0	23.5
-10	22.325
-15	19.975

|表 5.2: QSF の変化割合と電流値 ||表 5.3: QSD の変化割合と電流値

change ratio [%]	QSD [A]
10	27.5
5	26.25
0	25
-5	23.75
-10	22.5

利用したビームのエネルギーは 3.0 GeV であった。また、コリメータ を用いなかったため広めのビームとなっていた。

シミュレーションとの比較 5.2

測定で得られたビーム形状とシミュレーション結果について、概形、焦 点位置、広がりの3つの観点から比較し、一致度について述べる。なお、 実測データについては第4章で議論した閾値、クラスタリングを考慮し、 検出器の効率を反映させたものを用いる。

5.2.1 SADを用いたシミュレーションの用意

ビーム形状のシミュレーションのために、SAD(Strategic Accelerator Design)を用いた。SADとは、1986年よりKEKにおいて開発されてきた 加速器設計のための計算機コードである。現在テストビームラインにて 規定値として設定されているQマグネットの電流値を決定するために用 いられてきた SAD スクリプトを利用し、コンバータで発生した初期粒子 の経路のシミュレーションを行った。シミュレーションでたどったビームの経路を図 5.2 に示す。



図 5.2: シミュレーションの経路

ここで考慮するものは、図5.2に緑と黄色の四角で示された5種類の電 磁石による磁場が及ぼす影響、リングとステージを隔てるシールドおよび 各電磁石について設定したビーム開口範囲の2点のみであり、相互作用や それに伴い生成された二次粒子等については考慮しない。また、ビーム 開口範囲を逸脱した粒子についてはその時点で検出器まで到達しなかっ たものと見なす。

ビーム開口範囲は、Bマグネットについて*x*方向±30*mm、y*方向±17*mm*、 Qマグネットについて半径26*mm、シール*ドについて半径28*mm*とした。

5.2.2 ビーム形状の比較

いくつかの条件での測定データとシミュレーション結果を図5.4、図5.7、 図5.8、図5.9に示す。ここでは、4.2.4節でも述べたように、図5.3にお いて赤い点2カ所に電子が到達した場合でも黒矢印で示された2点を含 む計4点に電子が到達したと扱われる事象を排除するため、1イベントに おいて1クラスターのみが閾値を超えた場合に限り有効なデータとして 扱っている。



図 5.3: 排除すべき事象 (図 4.12 再掲)

図5.4について測定データとシミュレーション結果を見比べると、どち らも x = 0mm、y = 0mmの位置に最も強くビームが当たっており、x方 向に少し長い楕円形となっていることが確認できる。ビームの広がりに 関しては測定データの方がかなり大きくなっていた。特にy方向につい ての差が大きくなっており、これはQSFでy方向に広げられるため、シ ミュレーション上にてその後のQSDに設定したビーム開口範囲の外を通 過する電子が x 方向よりも多くなることが要因として考えられる。また 測定データには縦横に青い筋が見られるが、これらは検出器の性能によ るものであり、4.2.5 節で述べたように実験セットアップの問題で検出効 率が正確に求められなかったチャンネルの影響が見えていると考えられ る。図 5.5、図 5.6 に示した各方向の一次元ヒストグラムにて大きくへこ んでいる部分がこれにあたる。



図 5.4: 上流において全て既定値の場合の二次元ヒストグラム。 (左)測定データ (右) シミュレーション結果



 図 5.5: 上流において全て既定値の場合のx方向一次元ヒストグラム (左)測定データ (std.dev: 10.43±0.01 mm)
 (右) シミュレーション結果 (std.dev: 3.36±0.05 mm)



図 5.7: 下流において全て既定値の場合の二次元ヒストグラム

- (左)測定データ
- (右) シミュレーション結果

電流値を変えずに検出器を下流に移動させたときの形状を図 5.7 に示 す。図 5.4 と比較すると、測定データ、シミュレーション結果ともに x 方 向により広げられ y 方向により絞られるように変化している。このこと から、x 方向の焦点は検出器上流に、y 方向の焦点は検出器下流に位置し ていると推測できる (詳しくは 5.2.3 節で議論する)。

検出器を下流に設置したままQマグネットの電流値を変化させたとき



図 5.8: 下流において QSD のみ 10 % 強めた場合の二次元ヒストグラム (左) 測定データ

(右) シミュレーション結果

の形状を図 5.8、図 5.9 に示す。図 5.8 は QSD のみ 10% 強めた場合、図 5.9 は QSF のみ 15% 強めた場合のものである。まず図 5.7 と図 5.8 を比較す ると、QSD を強めると x 方向により広げられ y 方向により絞られるよう に変化している。QSD は x 方向にビームを広げ y 方向に収束させる向き に力を働かせるので、QSD の理解と実測、シミュレーションでの形状変 化が一致していると言える。図 5.9 についても図 5.7 と比較すると、どち らも x 方向に大きく広げられている。図 5.7 の考察において x 方向の焦 点が検出器上流にあると推測したが、QSF を強めると x 方向の焦点はよ り上流に動くはずであることからこの変化を説明できる。y 方向について は測定データでは少し広げられたがシミュレーション結果ではあまり変 化がないように見える。これは図 5.4 の考察で述べたように、シミュレー ションにおいて QSD に設定したビーム開口範囲による制限の影響が大き いからだと考えられる。

5.2.3 焦点位置の比較

Qマグネットの電流値を変化させた際の焦点位置の変化について比較 を行う。焦点位置の導出方法として、Qマグネットの電流値を変更せず に検出器を上流および下流にそれぞれ設置した場合におけるビームの広 がりを求め、これらの値から広がりがゼロとなる位置を計算する手法を 採用した (図 5.10)。今回、ビームの広がりとして図 5.5、図 5.6 に示した ような一次元ヒストグラムの標準偏差を用いた。



図 5.9: 下流において QSF のみ 15 % 強めた場合の二次元ヒストグラム (左) 測定データ

(右) シミュレーション結果



図 5.10: 焦点位置の導出

QSFを規定値に固定し、QSDのみ電流値を変化させた場合の焦点位置の変化を図 5.11、図 5.12 に示す。



図 5.11: QSD を変化させた場合の *x* 方向焦点位置



図 5.12: QSD を変化させた場合の *y* 方向焦点位置

x方向、y方向ともにQSDを強めると焦点位置がzの負の向き、すなわち上流に移動することが確認できる。x方向については、図 5.13 のようにQSD が働くとQSF で収束された後にx方向に広げられるため(図 5.13赤矢印)、見かけ上の焦点が上流に移動すると考えられる。y方向については、QSD を強めるとy方向に強く収束されることになるため、焦点が上流側に移動する。



図 5.13: QSD の変化に伴う x 方向焦点の移動

測定データ、シミュレーション結果ともに変化の傾向は同じであった が、測定データのほうが傾きが小さくなっていたことから、QSDの影響に ついて実際はシミュレーションほど強く出ないということが推測できる。

5.2.4 広がりの比較

Qマグネットの電流値を変化させた際のビームの広がりの変化につい て比較を行う。ここでも 5.2.3 節と同様にビームの広がりとして一次元ヒ ストグラムの標準偏差を用いた。

以下の図 5.14、図 5.15、図 5.16、図 5.17 に測定データとシミュレーション結果の広がりについてのグラフを示す。

図 5.14、図 5.15 は QSF を変化させたとき、図 5.16、図 5.17 は QSD を 変化させたときの x 方向、y 方向の広がりをそれぞれ表したものである。 いずれの条件であっても前節で述べた通りビームの広がりの絶対値は測 定データのほうがはるかに大きいが、測定データとシミュレーション結 果は概ね同様の変化をしていることが確認できた。

QSF を変化させたときの x 方向の変化 (図 5.14) について、QSF の電流 値を大きく変化させるとより x 方向に広がっていた。これより、現在の QSF の規定値は x 方向にビームを絞る観点からは悪くない値であると言



図 5.14: QSF を変化させた場合 の *x* 方向の広がり



図 5.16: QSD を変化させた場合 の *x* 方向の広がり



図 5.15: QSF を変化させた場合 の *y* 方向の広がり



図 5.17: QSD を変化させた場合 の *y* 方向の広がり

える。対して *y* 方向の変化 (図 5.15) については、QSF の電流値を強くす るほど広がりが大きくなっていった。測定データの方が変化が大きかっ たことから、QSF の *y* 方向への影響は実際はシミュレーションより強く 出るだろうと推測できる。

次にQSFを変化させたときの変化について、x方向(図5.16)ではシミュ レーション結果ではQSDの電流値を強くするほど広がりが大きくなって いったが、測定データはあまり変化しなかった。反対にy方向(図5.17) ではどちらもQSDの電流値を強くするほど広がりが小さくなっていき、 変化の程度は測定データの方が大きかった。変化の程度の差より、シミュ レーションと比較して実際のQSFの影響はx方向には弱く、y方向には 強く出ていることが推測できた。

また、5.2.2節でも述べたように測定データの方がシミュレーション結 果よりも広がりが大きくなっていた。この要因についてはいくつか考え られる。まず測定データ側の要因として、二次粒子の影響がある。今回 は二次粒子によるイベントも含めてクラスタリングを施した後に5.2.2節 の冒頭で述べたイベント選択(図 5.3)を行ったものを測定データとして 扱った。この手順ではクラスタリングの時点で二次粒子の影響を受ける こととなり、実際よりもビームが広がって検出される可能性が考えられ る。次にシミュレーション側の要因として、ビーム開口範囲の設定によ り起こる問題と二次粒子による影響がある。シミュレーションを行う際 に、5.2.1節で述べたようにQマグネットでは磁場の乱れが少ないと考え られる半径 26 mm のビーム開口範囲を設定した (図 5.18 の赤い○で囲ん だ範囲)。しかし、実際にはこの外側を通った粒子もQマグネットの磁場 の影響を受けて検出器に到達する可能性は十分に考えられる。また、今回 のシミュレーションではビームと加速器を構成する物質との相互作用や 二次粒子については全く考慮していない。これらのことからシミュレー ション上では実際のビームよりも絞られた結果が現れたと考えられる。



図 5.18: Qマグネットの通過可能範囲 [6]

5.3 測定データとシミュレーション結果の一致度 と問題点

5.2節での議論より、測定データとシミュレーション結果では電流の変 化に対するビーム形状の変化傾向は一致しているものの、各磁石の影響 の強さについては差異が見られることが確認された。したがって、SAD は概ね実際のビームを再現できているといえるが、再現度の向上にはさ らなる改良の余地があると考えられる。具体的には、5.2.4節で述べた通 過可能範囲設定の見直しや、二次粒子の考慮などが挙げられる。磁石の 影響の強さにおける差異の原因については、さらに詳細な調査が必要で ある。

SAD の改良に加えて、測定データに関してより正確な結果を得るため には、いくつかの課題が残されている。まず、検出器の検出効率を正確 に求めるために手法の見直しが必要である。特に4.2節で述べた効率測定 実験の方法に問題があり、トリガーシンチレータの移動幅を5mm程度に 狭めて再測定を行うことで改善が期待される。また、今回の解析では二 次粒子について考慮せずに行ったが、これらを考慮した解析を行うこと でさらに正確性の向上が見込まれる。

これらの改善を施した上で同様の実験を行うことで、ビームの改良に 向けたより詳細な指針を得ることができると考えられる。

第6章 電磁シャワー形状測定 実験

この章では、ファイバー検出機による電磁シャワー測定について述べ る。目的はシャワーの進んだ距離に対するシャワーの発展を調べること である。シャワーの広がりを反映した数値として1イベント中で信号が 来たチャンネル数を測定し、シャワーの進んだ距離との関係を調べた。

6.1 電磁シャワー生成の原理

電磁シャワーとは、高エネルギーの粒子が物質中を進むときに、制動 放射と電子陽電子対生成が連鎖的に起こり、多数の粒子が生成される現 象である (図 6.1)。



図 6.1: 電磁シャワーの概略

シャワーの振る舞いは、放射長 X_0 と criticall energy E_c を用いて表すこ とができる。エネルギー E_0 の電子が物質中を x 進んだ後のエネルギー E

$$E = e^{-x/X_0}$$

と表せる。シャワーは電子のエネルギーが*E_c*を下回るまで広がる。*E_c*は, 制動放射と電離作用の起こる確率が等しくなるエネルギーである。ビー ムエネルギー*E_b*としてシャワーが進む距離を計算すると、

$$E_c = E_b e^{-x/X_0}$$
$$e^{-x/X_0} = \frac{E_c}{E_b}$$
$$x = \ln\left(\frac{E_b}{E_c}\right) X_0$$

この実験では 3GeV のビームを使用し、鉛と鉄による電磁シャワーを測定 した。 $X_{0 \text{ 鉄}} = 17.6$ mm, $X_{0 \text{ \pounds}} = 5.6$ mm であるから, $x_{\text{ \pounds}} \simeq 5X_0$, $x_{\text{ \pounds}} \simeq 6X_0$ である。

6.2 実験のセットアップ

実験のセットアップの概略を図 6.2 に示す



図 6.2: 電磁シャワー測定のセットアップ

検出器の前に鉄または鉛のブロックを置き、ビームを当てることでシャ ワーを観測した。用いた金属ブロックは、鉄12mm、鉛20mm, 50mm で ある。これらのブロックを組み合せて設置することで、シャワーの進む 物質量を調節した。調べたブロックの組み合わせを表 6.1 に示す。

全厚さ z(mm)	Fe(12mm)	Pb(20mm)	Pb(50mm)	z/X_0
12	1	0	0	0.7
20	0	1	0	3.6
24	2	0	0	1.4
32	1	1	0	4.3
36	3	0	0	2.0
40	0	2	0	7.1
48	4	0	0	2.7
50	0	0	1	8.9
60	0	3	0	10.7
70	0	1	1	12.5
90	0	2	1	16.1
100	0	0	2	17.9
120	0	1	2	21.4

表 6.1: ブロックの組み合わせ

トリガー条件としては加速器リング内、マグネット後、検出器直前の 1cm 各のシンチのコインシデンスとし、検出器の中心付近で起こるシャ ワーを捉えられるようにした。

6.3 解析方法

解析は、geant4シミュレーションとの比較により行った。シミュレー ションは、金属ブロックと検出器を実際と同じ位置に置いて行った。検 出器はファイバーのみとして、断面は図 4.10 のように長方形で再現した。 初期粒子は、検出器直前のシンチから生成 (図 6.3)。検出器の位置での位 置と分散が測定値と一致するようにした (図 6.4)。

解析では、各イベントで光ったチャンネル数について、シミュレーショ ンと測定結果を比較した。ファイバーが光ったかどうかは、測定結果で は ADC 値、シミュレーションではエネルギー損失から判定する。測定結 果の閾値は、平均光電子数から求めたものを用いた。シミュレーション 結果の閾値は図 4.13 より、0.15 MeV とした。



図 6.3: シミュレーションのセットアップ

6.4 結果

各チャンネルが光った回数を図6.5に示す。



図 6.5: 各チャンネルの光った回数/全イベント数



図 6.4: 初期粒子の分布

シャワーの横方向の広がりを検出器が捉えられていることが分かる。 1イベントで光った本数を図 6.6 に示す。



図 6.6: 1イベントで光ったチャンネル数 (規格化)

この本数の平均値をシャワーの粒子数を表す数と考え、これとシャワー の進んだ距離との関係を調べた。シャワーの距離は放射長で換算した。こ れにより、シャワーの縦方向の発展が分かる (図 6.7)。



図 6.7: シャワーの縦方向の発展

鉄のみ、鉛のみを設置した場合の実験結果はシミュレーション結果と 一致した。しかし、鉛 20 mm と鉄 12 mm を組み合わせて設置した実験 結果 (4.3X₀) は、鉄のみ、鉛のみのシミュレーションのいずれとも一致し ていない。一方で、実際の測定と同じように鉄 12 mm と鉛 20 mm を設 置したシミュレーションは、測定結果と一致している (図 6.8)。6.1 節で は、シャワーの終点が最後の物質の critical energy に依存すると考えた。 だが、実際にはシャワーの広がりは終点以外の物質の影響も受けている と考えられる。



図 6.8: 鉄 20 mm+鉛 12 mm の結果

また、シミュレーション結果のシャワーの広がる距離(同時に光るチャ

ンネル数がピークとなる放射長) は、6.1 節の計算より1 放射長程度小さい。これは、粒子数が増えると複数の粒子が同じファイバーに入る事象が増え、ファイバーの光る本数の方が先にピークになるためであると考えられる。

以上より、1種類の物質を通ったシャワーに関しては、その振る舞い が放射長で説明できることがわかった。

第7章 結論

本研究では、KEK 測定器開発テストビームラインにおけるビーム形状 についてシミュレーション結果と測定で得られた結果の一致度を調査し た。その結果、四重極磁石の電流値を変化させた際のビーム形状の変化 は測定データとシミュレーション (SAD) で傾向が一致していることが確 認された。この結果より、SAD は概ね実際のビームの変化を再現できて おり、また、ファイバー検出器の結果に基づいてビーム最適化の方針を立 てるのは適切であると考えられると結論づけられる。ただし、測定デー タと SAD の各磁石の影響の強さについては差異が確認されたため、再現 度の向上にはさらなる改良の余地があるといえる。

また、電磁シャワーの測定結果はシミュレーション結果と概ね一致し ており、シャワーの振る舞いが放射長で説明できることも確かめられた。 さらに、解析時に NIM-EASIROC の特性についても明らかとなり、補正 を行うことで測定でのデータ収集において適切に機能することが確認さ れた。

しかし本研究には複数の問題が残されており、これらによる結果への 影響は無視できないと考えられる。まず、より正確な結果を得るために はより精度の高い検出効率が必要であり、そのためには効率測定実験の 手法の改善が求められる。また、ビームの広がりは両者に大きな差が見 られたため、この点についても改善が必要である。手法としては、より実 際の実験セットアップにより近い形となるようシミュレーションのセッ トアップを変更することや、二次粒子について考慮するための追加実験 や解析を行うことが挙げられる。さらに本研究ではビーム形状測定にお いて測定位置として2点取ったが、より詳細に形状変化の傾向を把握し ビーム最適化の指針とするためには、マグネットの上流側も含めて測定 点を増やすことも必要だと考えられる。

本研究を通じてビーム形状の観点から測定データとシミュレーション の一致度を概ね把握し、シミュレーションの精度向上やビームラインの 改善に向けた指針を得ることができた。今後、シミュレーションの修正 や測定点を増やした測定を行うことでさらに詳しい指針を得ることが可 能であり、それによって KEK 測定器開発テストビームラインの電子ビー ムをより絞ることができると期待される。

謝辞

本研究にご協力いただいた皆様に、心より感謝申し上げます。

まず、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構のARTBLを ご担当の皆様には、ビーム利用許可をいただき、誠にありがとうござい ました。特に、素粒子原子核研究所の中村勇講師には、受け入れ手続き や責任者としてのご指導において多大なご支援を賜り、深く感謝してお ります。

また、素粒子原子核研究所の岡崎佑太助教には、シミュレーションツー ルSAD についてのご指導をいただき、非常に有益な助言を得ることがで きました。さらに、神戸大学大学院理学研究科博士課程前期課程1年の 佐野友麻氏、佐倉慶汰氏、浅見優輝氏、笹田真宏氏には、実験シフトの実 施にご協力いただきましたことに、心から感謝申し上げます。 皆様のご支援に心より感謝いたします。

関連図書

- [1] KEK, "つくばキャンパス 2023", ID:38230
 URL: https://www.kek.jp/ja/imagearchive/38226/.
- [2] "PF-AR の測定器開発テストビームライン建設計画", PASJ2021 MOP049 URL: https://www.pasj.jp/web_publish/pasj2021/ proceedings/PDF/MOP0/MOP049.pdf.
- [3] 測定器開発テストビームライン 写真集
 URL: https://photos.google.com/share/AF1QipPCV90fzabSD4eY7q_
 pV6a-zLWWr06enSFR00_Ucn8p01FWrqEVYAbhrB2YPIu4bg?key=
 Yy1uaFlkVElvWFJiaV9vUmZuNzZoRk5SeGRPX1N3.
- [4] HAMAMATSU 技術資料 URL: https: //www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/ documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/mppc_kapd9008j.pdf.
- [5] Geant4 Home Page URL: https://geant4.web.cern.ch/.
- [6] AR Test Beamline 写真集 URL: https://photos.app.goo.gl/dBiR6omGe1bnChRz9.
- [7] KEK, "PF-AR 計画" URL: https://www2.kek.jp/ja/tour/electron-31.html.
- [8] KEK, SAD Home Page URL: https://acc-physics.kek.jp/SAD/.